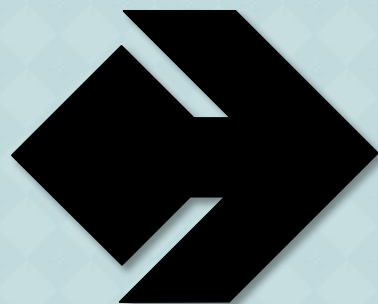


АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов – сборка»





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ – СБОРКА”

АО "ВЗПП-С" является одним из крупнейших поставщиков элементной базы для предприятий - изготовителей радиоэлектронной продукции, средств связи и важнейшей аппаратуры специального назначения.

АО "ВЗПП-С" выпускает разнообразную микроэлектронную и полупроводниковую продукцию.

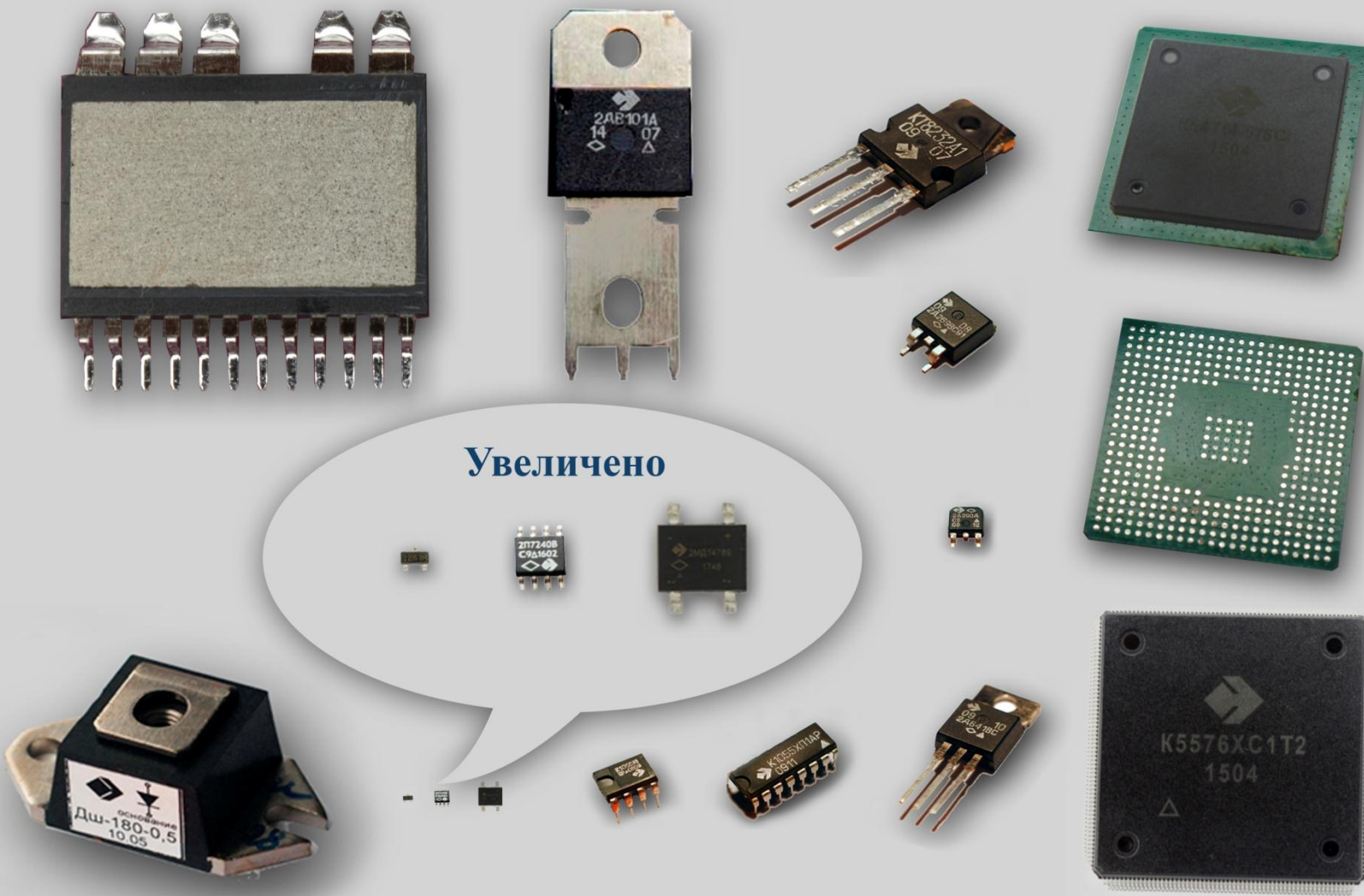


ОСНОВНАЯ СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ (БОЛЕЕ 400 ТИПОМИНАЛОВ):

- ❖ изделия микроэлектроники специального назначения (транзисторные сборки, логические ИС, ПЛМ, однократно и многократно программируемые ПЛИС), в т.ч. радиационно-стойкие, емкостью от 50 до 1200 тыс. вентилей);
- ❖ широкая номенклатура изделий силовой электроники, в т.ч. специального назначения:
 - мощные n- и p-канальные полевые транзисторы;
 - биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ);
 - мощные диоды Шоттки;
 - мощные высоковольтные быстровосстанавливающиеся диоды;
 - выпрямительные мосты на основе мощных диодов , в т.ч. специального назначения;
- ❖ силовые модули на основе полевых транзисторов и диодов;
- ❖ стабилизаторы напряжения;
- ❖ преобразователи напряжения;
- ❖ драйверы;
- ❖ автомобильная электроника (серия интегральных микросхем и транзисторы);
- ❖ отладочные платы для ПЛИС.



ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРПУСА

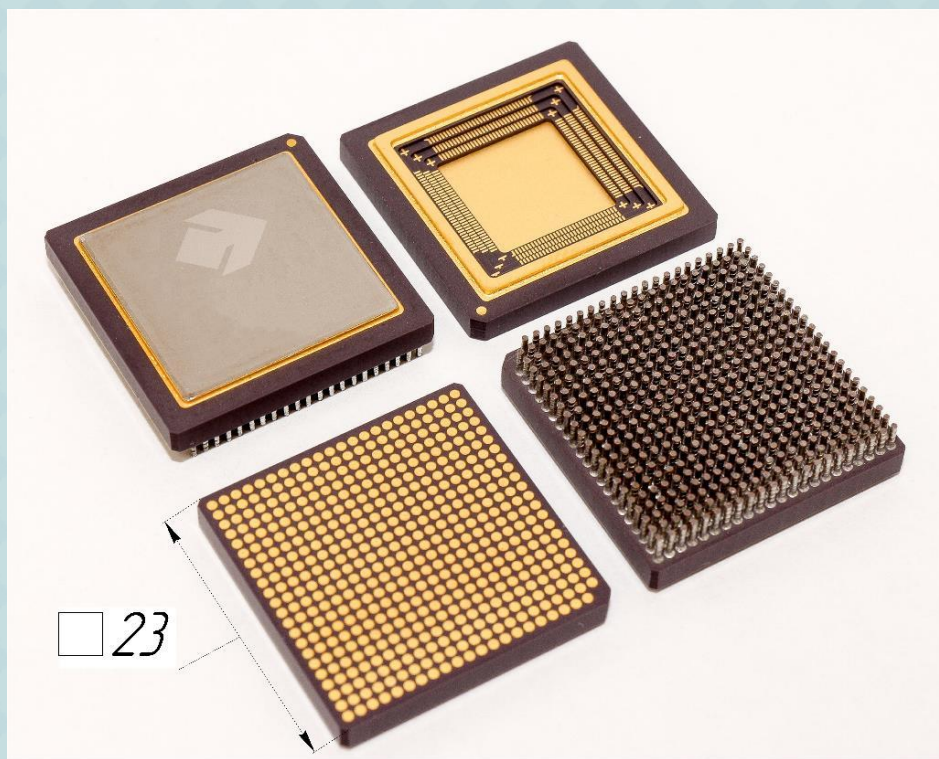
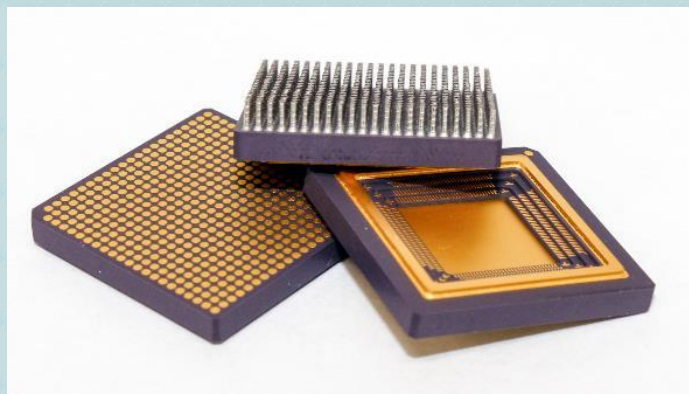


ЗАВОД ОБЛАДАЕТ:

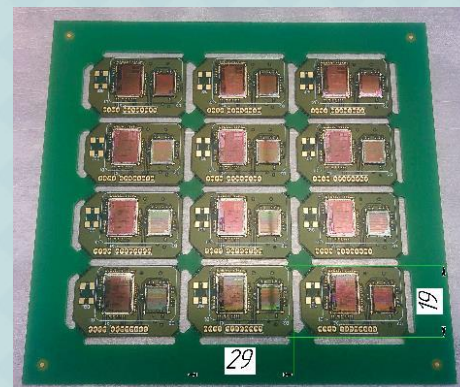
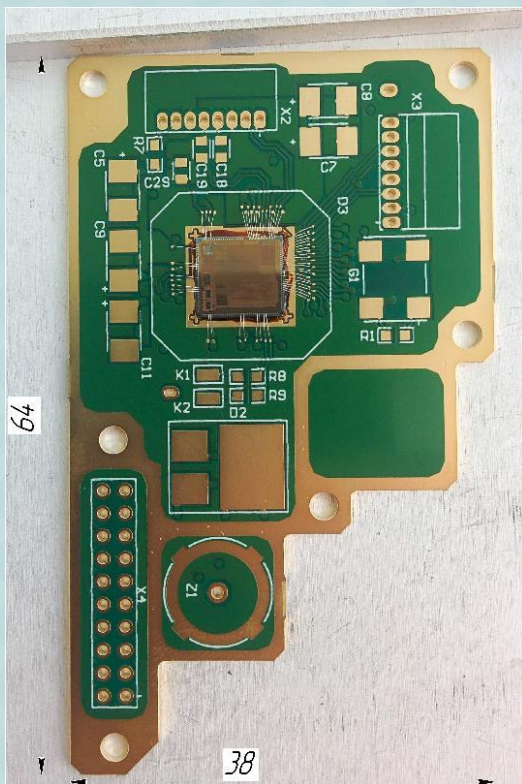
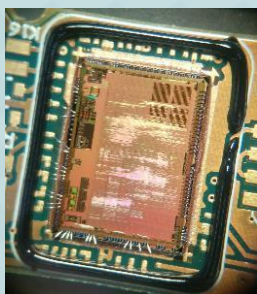
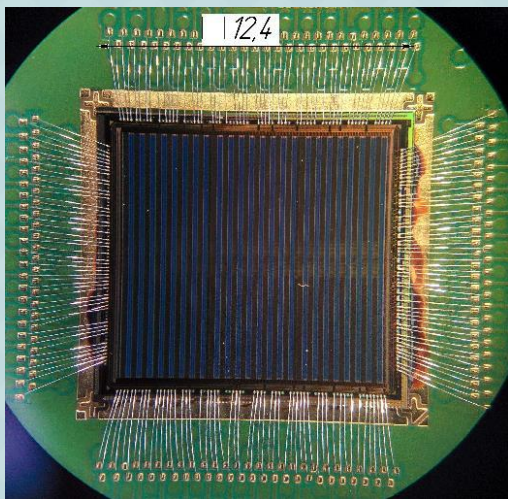
- ❖ технологией сборочного производства интегральных микросхем в металлокерамических корпусах (14, 16, 20, 24, 48, 240, 256, 304, 352 вывода);
- ❖ технологией сборочного производства интегральных микросхем в пластмассовых корпусах (8, 16, 20, 28, 48 выводов);
- ❖ технологией сборочного производства СВЧ – транзисторов;
- ❖ технологией сборочного производства силовых полупроводниковых приборов в корпусах пластмассовых, металлокерамических и металlostеклянных: SOT-89, TO-220, КТ-28А-2.01, ТО-3, ТО-204, ТО-218, КТ-43А-01.01, D2РАК, DРАК, ТО-257, ТО-254, SMD и др.;
- ❖ технологией производства силовых модулей на основе полевых транзисторов, диодов Шоттки и быстровосстанавливающихся высоковольтных диодов в корпусах: ТО-244, Д-67, ТО-244М;
- ❖ технологией производства кремниевых структур с диэлектрической изоляцией;
- ❖ сборка и герметизация бескорпусных кристаллов на печатных платах по технологии Chip-On-Board;
- ❖ технологией производства в различных многовыводных металлокерамических и пластмассовых корпусах, как отечественного, так и импортного производства, в том числе ССГА (корпуса со столбиковыми выводами) и ВГА (корпуса с шариковыми выводами).



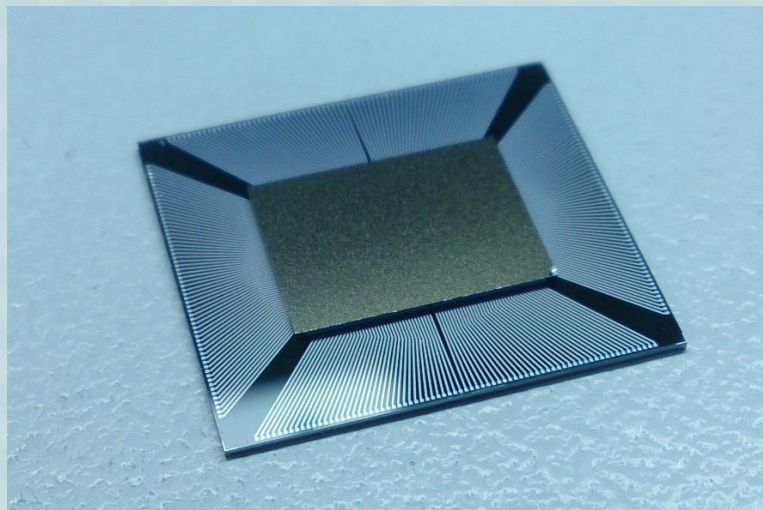
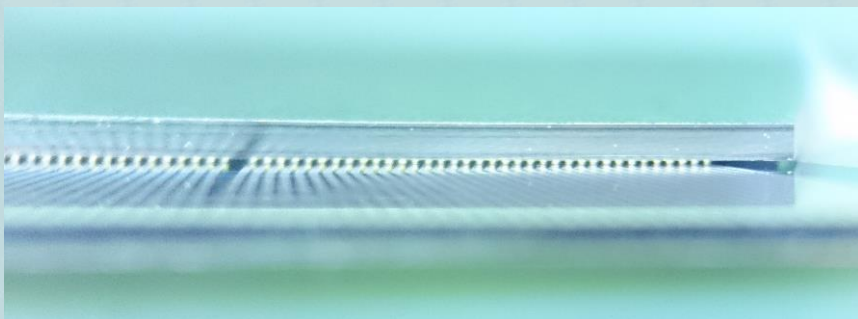
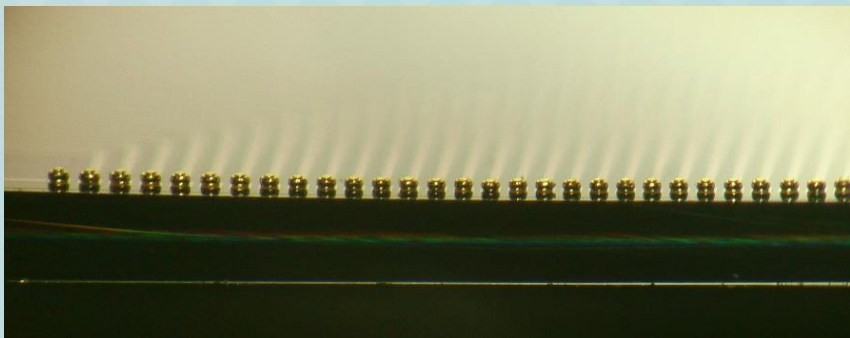
СБОРКИ В МНОГОВЫВОДНЫХ КОРПУСАХ ССГА



СБОРКА КРИСТАЛЛОВ В БЕСКОРПУСНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ CHIP-ON-BOARD



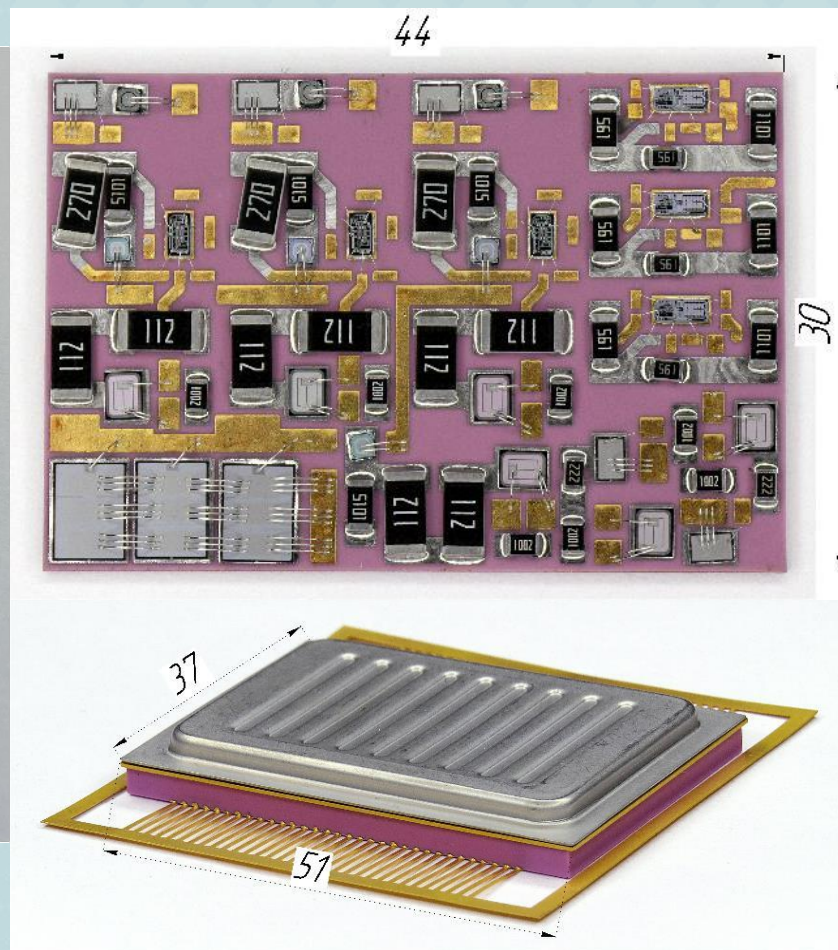
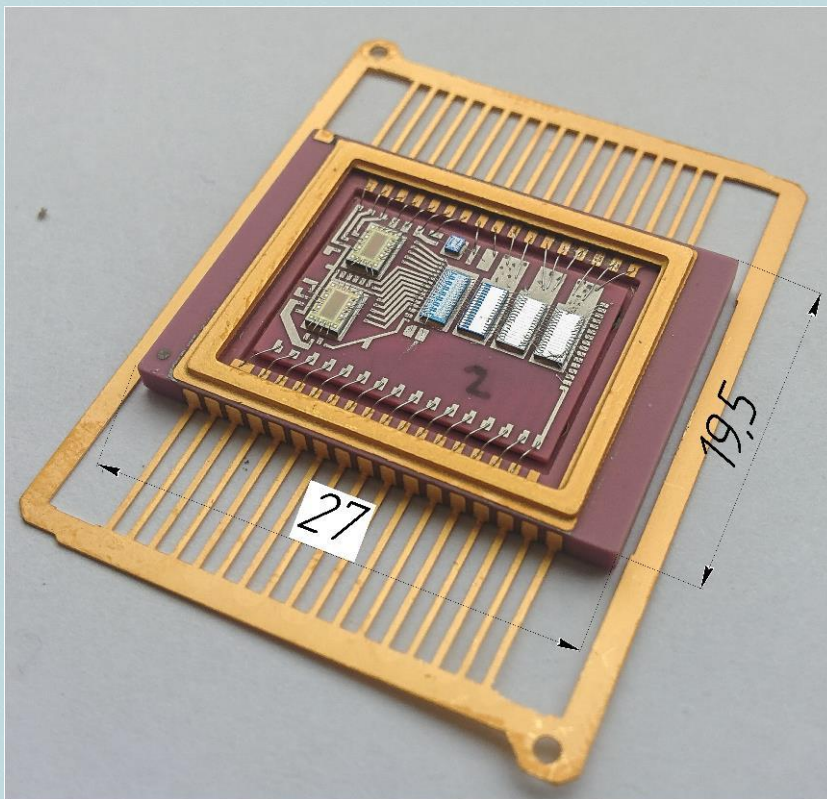
СБОРКА ПО ТЕХНОЛОГИИ FLIP-CHIP



Размер кристалла 12,3×9,3 мм

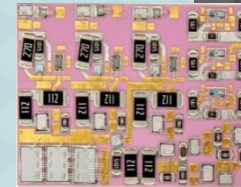
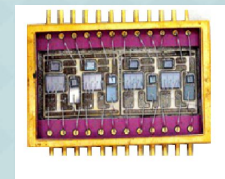
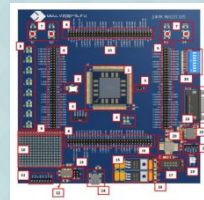
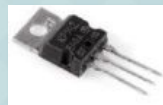


МНОГОКРИСТАЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ МОДУЛИ



НОВЫЕ РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ЭРИ

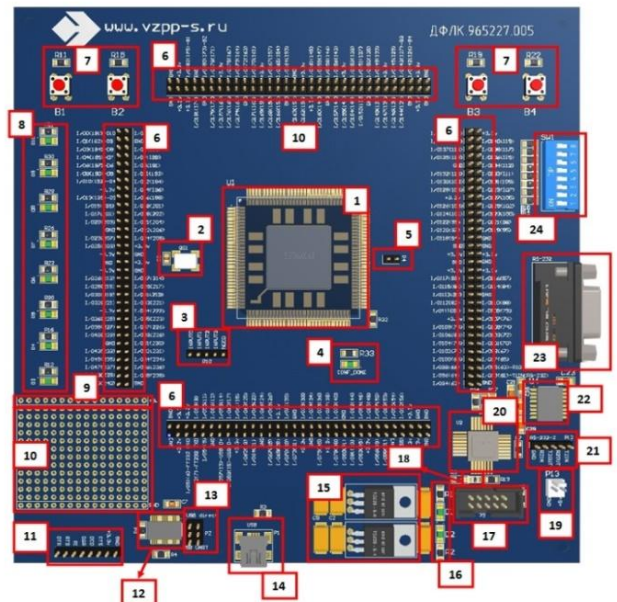
- ИМС управления ИМ, ИМС контроля токов ЭМТ, ИМС управления ВИП, ИМС преобразования входных ДС
- ГИС модуля ввода и вывода
- ИМС драйвера управления силовыми МОП-транзисторами и IGBT нижнего уровня (аналог IR4427,IR4426,IR4428)
- ИМС драйвера управления ДМОП ПТ и IGBT нижнего и верхнего уровней (аналог RIC7113)
- ИМС драйвера нижнего уровня с расширенными функциями (аналог IXD_604)
- ИМС корректора коэффициента мощности (аналог IR1155s)
- ИМС линейных и импульсных понижающих стабилизаторов напряжения положительной и отрицательной полярности с входным напряжением до 40В и токами от 100 мА до 5А
- Кремниевые диоды Шоттки на рабочее напряжение 18...200 В
- Быстровосстанавливающиеся GaAs p-i-n диоды на напряжение 600В и токи 1А, 15А
- Ультрабыстрые выпрямительные диоды и выпрямительные мосты на их основе на токи 0.1—30 А и напряжения 200-600 В
- Мощные IGBT (1200-2500В ,30-50А) с антипаралельным диодам на одном кристалле
- n- и р- канальные trench-MOSFET с напряжениями 30, 60, 100 В , в том числе с пониженной входной емкостью
- JFET-транзисторы на основе GaAs ($U_{си}=600В$, $I_c=10А$)
- Отладочные платы для ПЛИС 5578ТС084, 5578ТС094



АО «ВЗПП-С»



ОТЛАДОЧНАЯ ПЛАТА ОП5578ТС024.01



| № | Название | № | Название |
|----|---|----|---|
| 1 | ПЛИС 5578ТС024 | 13 | Сервисные выводы микросхемы FT232RL |
| 2 | Тактовый генератор 50 МГц QG1 | 14 | Разъем mini USB (A) |
| 3 | Служебные выводы ПЛИС | 15 | Стабилизаторы питания серии 1335 |
| 4 | Светодиод CONF_DONE - индикатор конфигурации ПЛИС | 16 | Индикация наличия питания |
| 5 | Вывод внешнего тактирования | 17 | JTAG - разъем |
| 6 | Пользовательские выводы ПЛИС | 18 | Переключатель для работы без микросхемы памяти |
| 7 | 4 кнопки | 19 | Разъем для подключения питания 5В |
| 8 | 8 светодиодов | 20 | Микросхема памяти 5576PC1У 4 Мбит |
| 9 | Монтажное поле - питание 3.3В | 21 | Второй канал RS232 |
| 10 | Монтажное поле с шагом 2.54 мм | 22 | Микросхема согласование уровней MAX232 (RS-232) |
| 11 | Служебные выводы UART конвертора FT232RL | 23 | Разъем DB-9 RS 232 |
| 12 | Преобразователь USB-UART | 24 | Переключатель DIP_SWITCH_8 |





АО «ВЗПП-С»





АО «ВЗПП-С»





АО «ВЗПП-С»





АО «ВЗПП-С»





АО «ВЗПП-С»





АО «ВЗПП-С»





АО «ВЗПП-С»



ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Высшее образование

- ❖ ВГУ (Воронежский государственный университет)
- ❖ ВГТУ (Воронежский государственный технический университет)
- ❖ ВИВТ (Воронежский институт высоких технологий)



Среднеспециальное образование

- ❖ Промышленно-гуманитарный колледж
- ❖ Энергетический техникум

